



2SB1198K (3CG1198K)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途：用于一般中功率放大。

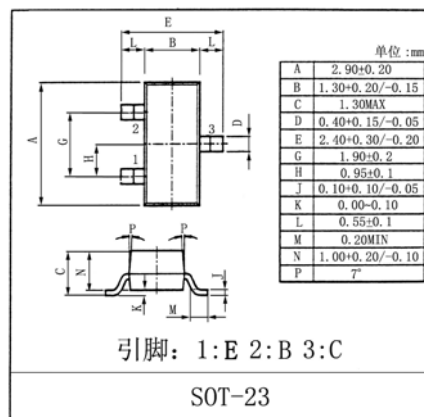
Purpose: Medium power amplifier applications.

特点：击穿电压高，饱和压降低，与 2SD1782K (3DG1782K) 互补。

Features: High breakdown, low  $V_{CE(sat)}$ , complements the 2SD1782K (3DG1782K).

极限参数/Absolute maximum ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
$V_{CBO}$	-80	V
$V_{CEO}$	-80	V
$V_{EBO}$	-5	V
$I_C$	-500	mA
$P_C$	200	mW
$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$	-55~150	$^\circ\text{C}$



电性能参数/Electrical characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
$V_{CBO}$	$I_C=-50\ \mu\text{A}$	-80			V
$V_{CEO}$	$I_C=-2\text{mA}$	-80			V
$V_{EBO}$	$I_E=-50\ \mu\text{A}$	-5			V
$I_{CBO}$	$V_{CB}=-50\text{V}$			-0.5	$\mu\text{A}$
$I_{EBO}$	$V_{EB}=-4\text{V}$			-0.5	$\mu\text{A}$
$h_{FE}$	$V_{CE}=-3\text{V}$ $I_C=-100\text{mA}$	120		390	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}$ $I_B=-50\text{mA}$		-0.2	-0.5	V
$f_T$	$V_{CE}=-10\text{V}$ $I_E=50\text{mA}$ $f=100\text{MHz}$		180		MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=-10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1\text{MHz}$		11		pF

$h_{FE}$  分档、印章/ $h_{FE}$  Classifications、Marking:

$h_{FE}$ 分档 $h_{FE}$ Classifications	Q	R
$h_{FE}$ 范围 $h_{FE}$ Range	120~270	180~390
印章 Marking	HAKQ	HAKR

